Zn/Cu(111)表面におけるギ酸の吸着と解離

The adsorption and dissociation of formic acid on Zn/Cu(111)

<u>塩澤佑一朗</u>、小板谷貴典、向井孝三、吉本真也、吉信淳 (東大物性研) <u>Y. Shiozawa</u>, T. Koitaya, K. Mukai, S. Yoshimoto, and J. Yoshinobu (ISSP, Univ. of Tokyo)

水素と二酸化炭素を原料としたメタノール合成反応は、Cu/ZnO 系触媒を用いて行われている。フォルメート (HCOO)は、この反応の中間体と考えられている [1]。Zn/Cu(111)表面におけるメタノール合成反応では、Zn が生成したフォルメートに結合していることが報告されている [2、3]。一方で、ギ酸 (HCOOH)は銅表面上で解離してフォルメートとなるため、メタノール合成の表面反応素過程の研究に良く用いられてきた [4]。Cu(111)表面では、低温でギ酸を吸着させてから加熱すると、モノデンテートフォルメートへ解離することが 2013 年に報告された [5]。 さらに加熱すると、モノデンテートフォルメートはバイデンテートフォルメートへ吸着構造変化する [5]。しかし、Zn/Cu(111)表面におけるギ酸の吸着と解離の微視的メカニズムは未だよく分かっていないのが現状である。

本研究では、Zn/Cu(111)表面におけるギ酸の吸着と解離を X 線光電子分光 (XPS) (KEK PF)を用いて調べた。図 1 は 82 K でギ酸を吸着させた Cn(111)、Zn/Cu(111)、酸素を曝露した Zn/Cu(111) 表面を 300 K に加熱したときの XPS スペクトル (O 1s)である。Cu(111)清浄面では、531.0 eV にバイデンテートフォルメートが観測された。Zn/Cu(111)表面で観測された 532.0 eV は、フォルメート種と帰属した。図 1 より、Zn の被覆率の増加につれてフォルメート種の生成量が減少することが分かった。発表では、過去に行ってきた Cu(111)表面におけるギ酸の吸着と解離のメカニズムをもとに、Zn/Cu(111)表面における解離反応を議論する予定である。

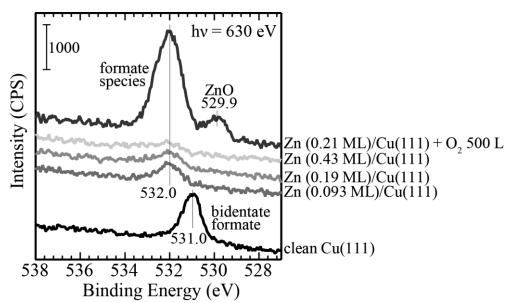


図 1. XPS の O 1s スペクトル。82 K でギ酸を吸着させた Cn(111)、Zn/Cu(111)、酸素を 500 L 曝露した Zn/Cu(111)表面を 300 K に加熱した。

[参考文献]

- [1] C. T. Campbell et al., Top Catal, **52**, 1440 (2009).
- [2] J. Nakamura *et al.*, Catalysis Letters, **35**, 297 (1995).
- [3] J. Nakamura et al., Surface Science, **402**, 92 (1998).
- [4] M. Bowker et al., J. Chem. Soc., Faraday Trans., 92, 4683 (1996).
- [5] A. E. Baber et al., Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 12291 (2013).